

تعداد سوال: نهضت: ۲۰ تکمیلی: — تشریفی: ۴

نام لرنس: الکترو مغناطیس ۲

زمان آزمون (دقیقه): تستی و تکمیلی: ۶۰ تشریفی: ۶۰

رشته نصیبی-گواش: فیزیک - (حالت جامد - هسته ای - اتمی و مولکولی)

کد لرنس: ۱۱۱۳۰۴۲

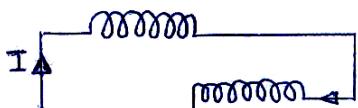
* دانشجوی گرامی: لطفاً گزینه ۱ را در قسمت کد سری سوال برگه پاسخنامه خود، علامت بزنید. بدیهی است، مسئولیت این امر بر عهده شما خواهد بود.

** این آزمون نمره منفی ندارد.

۱. دو سیم پیچ با تعداد دورهای N_1 و N_2 و با شعاع های تقریباً یکسان به شکل چنبره وجود دارند. اگر طول متوسط چنبره l باشد، ضریب القای متقابل این دو سیم پیچ برابر است با:

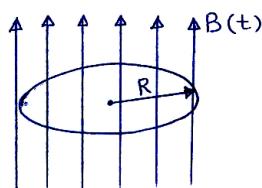
$$\text{الف. } \frac{\mu_0 N_1 N_2 I A}{l} \quad \text{ب. } \frac{\mu_0 N_1 N_2 I}{l} \quad \text{ج. } \mu_0 \sqrt{L_1 L_2} \quad \text{د. } \sqrt{L_1 L_2}$$

۲. دو سیم پیچ (القاگر) مطابق شکل زیر بهم بسته شده اند. اگر $L_1 = L_2 = L$ باشد، ضریب خود القایی موثر این مدار کدام است؟ (جريان در سیم پیچ ها خلاف جهت هم می باشند.)



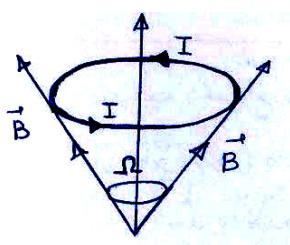
$$\text{الف. } \frac{5L}{3} \quad \text{ب. } \frac{7L}{3} \quad \text{ج. } \frac{4L}{3} \quad \text{د. } \frac{2L}{3}$$

۳. میدان مغناطیسی یکنواخت $B(t)$ مطابق شکل بر روی یک منطقه دایره ای به شعاع R اعمال شده است. اندازه میدان الکتریکی القا شده در لبه منطقه دایره ای کدام است؟



$$\text{الف. } \frac{R}{2\pi} \left| \frac{dB(t)}{dt} \right| \quad \text{ب. } \frac{R}{3} \left| \frac{dB(t)}{dt} \right| \quad \text{ج. } \frac{R}{2} \left| \frac{dB(t)}{dt} \right| \quad \text{د. } R \left| \frac{dB(t)}{dt} \right|$$

۴. مدار صلبی که شامل یک دور حلقه سیمی است، در میدان مغناطیسی یک نقطی مغناطیسی که بصورت شعاعی و متناسب با عکس مجدور فاصله است، $\vec{B} = \alpha \frac{\vec{r}}{r^3}$ ، قرارداد. اگر I شدت جریان در مدار و Ω زاویه فضایی باشد که توسط مدار از مرکز میدان در برگرفته می شود، انحراف مغناطیسی برابر است با:



$$\text{الف. } \alpha I \Omega \quad \text{ب. } \alpha I \quad \text{ج. } \alpha I \vec{I} \cdot \vec{\nabla} \Omega \quad \text{د. } \alpha I$$

تعداد سوال: نهانی: ۲۰ تکمیلی: — تشریفی: ۴

نام لرنس: الکترومغناطیس ۲

زمان آزمون (دقیقه): تستی و تکمیلی: ۶۰ تشریفی: ۶۰

رشته نصیبی-گواش: فیزیک - (حالت جامد - هسته‌ای - اتمی و مولکولی)

کد لرنس: ۱۱۱۳۰۴۲

۵. یک دسته مدار صلب حامل جریان که هیچ یک از آنها تا بینهایت ادامه ندارد، در محیطی با خواص مغناطیسی خطی قرار گرفته‌اند. کدام یک از گزینه‌های زیر رابطه صحیحی برای انرژی این دستگاه نیست؟

$$\frac{1}{\mu} \int \vec{H} \cdot \vec{B} dV \quad \text{د.} \quad \oint_{c_i} \vec{A} \cdot d\vec{l}_i \quad \text{ج.} \quad \frac{1}{\mu} \sum_i \oint_{c_i} I_i \vec{A} \cdot d\vec{l} \quad \text{ب.} \quad \frac{1}{\mu} \int_V \vec{J} \cdot \vec{A} dV \quad \text{الف.}$$

۶. کدام یک از قوانین زیر را نمی‌توان از معادلات ماکسول بدست آورد؟

- الف. قانون القای فاراده ب. قانون اهم ج. قانون بقای بار د. قانون بقای انرژی

۷. اگر در ناحیه‌ای از فضا میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایستا وجود داشته باشد، کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

الف. اگر چه در نواحی از فضا بردار پوئین‌تینگ می‌تواند صفر باشد، اما انتشار انرژی الکترومغناطیسی وجود دارد.

ب. چون الزاماً بردار پوئین‌تینگ در همه جا صفر است، لذا انتشار انرژی الکترومغناطیسی وجود ندارد.

ج. چون بردار پوئین‌تینگ می‌تواند غیر صفر باشد، پس انتشار انرژی الکترومغناطیسی وجود دارد.

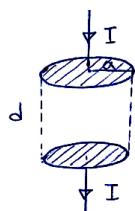
د. اگر چه در نواحی از فضا بردار پوئین‌تینگ می‌تواند غیر صفر باشد، اما انتشار انرژی الکترومغناطیسی وجود ندارد.

۸. اگر \vec{S} بردار پوئین‌تینگ، u چگالی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، ρ چگالی بار الکتریکی و \bar{J} چگالی جریان الکتریکی باشد، کدام یک از روابط زیر قانون بقای انرژی برای رساناهای را بیان می‌کند؟

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{S} + \frac{\partial u}{\partial t} = \bar{J} \cdot \vec{E} \quad \text{ب.} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{S} + \frac{\partial u}{\partial t} = -\bar{J} \cdot \vec{E} \quad \text{الف.}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \bar{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \text{د.} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{S} + \frac{\partial u}{\partial t} = -\bar{J} \cdot \vec{B} \quad \text{ج.}$$

۹. دو صفحه مسطح دایره‌ای به شعاع a که بفاصله d از هم قرار دارند، یک خازن‌ایدهآل را تشکیل داده‌اند. اگر عایق درون خازن یک عایق کامل بوده و میدان \bar{D} یکنواخت باشد و این خازن با جریان ثابت I در حال باردار شدن باشد، شدت میدان مغناطیسی H برابر است با:



$$H = \frac{I}{\pi a^2} \quad \text{د.} \quad H = \frac{a \frac{\partial D}{\partial t}}{\pi} \quad \text{ج.} \quad H = \frac{I}{\pi a} \quad \text{ب.} \quad H = a \frac{\partial D}{\partial t} \quad \text{الف.}$$

۱۰. در یک محیط با رسانایی ضعیف و با فرض اینکه واپستگی زمانی میدان الکتریکی بصورت $e^{i\omega t}$ باشد، نسبت اندازه جریان رسانشی به اندازه جریان جابجایی کدام است؟ (σ رسانندگی و ϵ ضریب گزندگی محیط است).

$$\frac{i\epsilon\omega}{\sigma} \quad \text{د.} \quad \frac{i\sigma\epsilon}{\omega} \quad \text{ج.} \quad \frac{\sigma}{i\omega\epsilon} \quad \text{ب.} \quad \frac{i\omega}{\sigma\epsilon} \quad \text{الف.}$$

تعداد سوال: نهان: ۲۰ تکمیلی: — تشریفی: ۴

نام لرنس: الکترو مغناطیس ۲

زمان آزمون (دقیقه): تستی و تکمیلی: ۶۰ تشریفی: ۶۰

رشته تحصیلی-گواش: فیزیک - (حالت جامد - هسته ای - اتمی و مولکولی)

کد لرنس: ۱۱۱۳۰۴۲

۱۱. یک موج تخت الکترو مغناطیسی از محیطی با مشخصات ϵ_1 , g_1 به محیط دیگری با مشخصات ϵ_2 , g_2 وارد می شود.
شرط آن که در فصل مشترک دو محیط بار سطحی آزاد وجود نداشته باشد، کدام است؟

$$\epsilon_1 g_1 \geq \epsilon_2 g_2 \quad \text{الف.} \quad \epsilon_1 \epsilon_2 = g_1 g_2 \quad \text{ب.} \quad \epsilon_1 g_1 = \epsilon_2 g_2 \quad \text{ج.} \quad \epsilon_1 g_2 = \epsilon_2 g_1 \quad \text{د.}$$

۱۲. امواج تخت تکفam با فرکانس f بر روی سطح فلزی با ضریب شکست \hat{n} می تابند. عمق پوسته این فلز برابر است با:

$$\frac{n\lambda}{2\pi k} \quad \text{الف.} \quad \frac{n}{2\pi k f} \quad \text{ب.} \quad \frac{c}{n\omega} \quad \text{ج.} \quad \frac{\lambda}{2\pi k} \quad \text{د.}$$

۱۳. موج تختی با معادله $\vec{E} = \hat{\vec{E}} e^{-i(\omega t - \hat{k} \cdot \vec{r})}$ بطور عمده بر سطح تخت یک رسانا با ضریب هدایت الکتریکی g می تابد. برای رسانا داریم: $\mu = \mu_0$, $\epsilon = \epsilon_0$. اگر مقدار جریان جابجایی دو برابر جریان رسانش در داخل رسانا باشد،

$$(\hat{n})^2 = k + i \frac{g}{\epsilon_0 \omega} \quad \text{رابطه ضریب شکست رسانا کدام است؟ (راهنمایی:)} \quad \text{راهنمایی:}$$

$$\sqrt{2+i} \quad \text{الف.} \quad \sqrt{k + \frac{i}{2}} \quad \text{ب.} \quad \sqrt{k+i} \quad \text{ج.} \quad \sqrt{k+2i} \quad \text{د.}$$

۱۴. در یک نارسانا اگر θ_B زاویه بروستر و θ_c زاویه حد باشند، کدام رابطه درست است؟

$$\theta_B + \theta_c = \frac{\pi}{2} \quad \text{الف.} \quad \theta_B > \theta_c \quad \text{ب.} \quad \theta_B < \theta_c \quad \text{ج.} \quad \theta_B = \theta_c \quad \text{د.}$$

۱۵. یک موج الکترو مغناطیسی بر روی سطح فلزی تابیده و سپس از روی سطح آن بازتاب می یابد. موج بازتاب یافته چه نوع موجی خواهد بود؟

- الف. موج پلاریزه بیضوی
ب. موج پلاریزه خطی
ج. موج پلاریزه دایروی
د. موج تخت

۱۶. اگر λ_c طول موج قطع یک موج بر و λ طول موج مربوط به موج هدایت شده باشد، سرعت فاز در داخل موج بر کدام است؟

$$c \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_c}{\lambda} \right)^2} \quad \text{الف.} \quad \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_c}{\lambda} \right)^2}} \quad \text{ب.} \quad c \frac{\lambda_c}{\lambda} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_c}{\lambda} \right)^2} \quad \text{ج.} \quad c \quad \text{د.}$$

۱۷. کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

الف. چگونگی انتشار امواج الکترو مغناطیسی در محیط های مادی خطی، بطور کامل با ثابت های اپتیکی n و k تعیین می شود.

ب. ثابت های اپتیکی یک محیط تنها به ثابت دی الکتریک k_e و رسانندگی g ماده (یا محیط) بستگی دارد.

ج. ثابت های اپتیکی یک محیط همواره به فرکانس موج تابیده شده بر محیط بستگی دارد.

د. ثابت های اپتیکی یک محیط مستقل از فرکانس موج تابیده شده بر محیط است.

تعداد سوال: نسخه: ۲۰ تکمیلی: — تشریحی: ۴

نام لرنس: الکترو مغناطیس ۲

زمان آزمون (دقیقه): تستی و تکمیلی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

رشته تحصیلی-گواش: فیزیک - (حالت جامد - هسته‌ای - اتمی و مولکولی)

کد لرنس: ۱۱۱۳۰۴۲

۱۸. اگر شتاب و سرعت یک ذره هم جهت باشند، کدام عبارت زیر صحیح است؟

- الف. تابش در امتداد جهت حرکت با افزایش سرعت افزایش می‌یابد.
 ب. تابش در امتداد جهت حرکت با افزایش سرعت کاهش می‌یابد.
 ج. تابش در امتداد جهت حرکت با شتاب متناسب است.
 د. تابش در امتداد جهت حرکت صفر است.

۱۹. مطابق مدل نوسانگ هماهنگ درود - لورنتس، معادله حرکت کلاسیک الکترون‌های مقید در اتم‌های یک ماده عبارتست

از: (E_m میدان مولکولی و γ ثابت میرایی است.)

$$\frac{d^{\text{th}}x}{dt^{\text{th}}} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^{\text{th}} x = \frac{eE_m}{m} \quad \text{ب.} \quad m \frac{d^{\text{th}}x}{dt^{\text{th}}} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^{\text{th}} x = \frac{eE_m}{m} \quad \text{الف.}$$

$$m \frac{d^{\text{th}}x}{dt^{\text{th}}} + \gamma \frac{dx}{dt} + \frac{\omega_0^{\text{th}}}{m} x = \frac{eE_m}{m} \quad \text{د.} \quad \frac{d^{\text{th}}x}{dt^{\text{th}}} + \frac{\gamma}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{\omega_0^{\text{th}}}{m} x = \frac{eE_m}{m} \quad \text{ج.}$$

۲۰. در منطقه تابش، میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی چه تابعی از فاصله تا چشمۀ میدان هستند؟

$$\text{ب. هر دو تابع } \frac{1}{r^3}$$

$$\text{الف. هر دو تابع } \frac{1}{r}$$

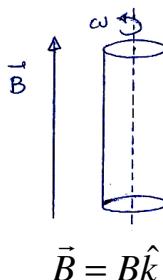
$$\text{ج. میدان الکتریکی تابع } \frac{1}{r} \text{ و میدان مغناطیسی تابع } \frac{1}{r^3} \quad \text{د. میدان الکتریکی تابع } \frac{1}{r^3} \text{ و میدان مغناطیسی تابع } \frac{1}{r}$$

سوالات تشریحی

* بارم هر سؤال تشریحی ۱/۷۵ نمره

۱. یک استوانه دی الکتریک با گذردهی \mathcal{E} و ضریب دی الکتریک k_e حول محور خود با سرعت زاویه‌ای ω می‌چرخد. اگر ایناستوانه در درون یک میدان مغناطیسی یکنواخت \vec{B} به موازات محور استوانه قرار گرفته باشد:

الف. بردار قطبش (با ذکر جهت آن)، ب. بارهای قطبشی القایی در دی الکتریک را بدست آورید؛ علت ایجاد بارهای قطبشی را
بطور مختصر توضیح دهید و نحوه قرارگیری شان را با رسم شکل نشان دهید.



تعداد سوال: نسخه: ۲۰ تکمیلی: — تشریفی: ۴

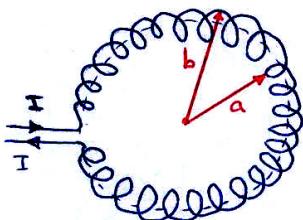
نام لرنس: الکترو مغناطیس ۲

زمان آزمون (دقیقه): تستی و تکمیلی: ۶۰ تشریفی: ۶۰

رشته تحصیلی-گواش: فیزیک - (حالت جامد - هسته‌ای - اتمی و مولکولی)

کد لرنس: ۱۱۱۳۰۴۲

۲. یک چنبره به شعاع متوسط R , شعاع داخلی a و شعاع خارجی b مفروض است. اگر مساحت حلقه‌های این چنبره A و جریان در هر حلقه I باشد، مطلوب است محاسبه ضریب خودالقایی (اندوکتانس) و انرژی مغناطیسی ذخیره شده در این چنبره N = تعداد حلقه‌های چنبره، $I = l$ = طول متوسط چنبره (جواب نهایی را بر حسب a و b بنویسید.)



۳. برای یک موج تخت در محیطی رسانا، $\hat{\vec{B}} = \frac{\hat{n}}{c} \vec{u} \times \hat{\vec{E}}$ می‌باشد. اگر فرض کنیم که میدان الکتریکی مطابق رابطه $\hat{\vec{E}} = E_p e^{i\phi} \vec{p} + E_s \vec{S}$ بوده و قطبش بیضوی داشته باشد، ثابت کنید در هر لحظه از زمان داریم:

$$\text{Re } \hat{\vec{E}} \cdot \text{Re } \hat{\vec{B}} = -\frac{k}{c} E_p E_s \sin \phi$$

۴. اگر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی حاصل از گروهی از بارهای متحرک محصور در داخل حجمی در فواصل دور بصورت زیر باشند:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) \approx \frac{\mu_0}{4\pi r} \vec{p} + \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{4\pi \epsilon_0 r^3 c^3} \vec{r} \quad , \quad \vec{B}(\vec{r}, t) \approx -\frac{\mu_0}{4\pi c} \frac{\vec{r}}{r^3} \times \vec{p} \quad , \quad \vec{p} = \frac{d^3 \vec{p}}{dt^3}$$

با توجه به روابط فوق:

الف. نشان دهید که چنین تابش‌هایی عرضی هستند.

ب. بردار پوئینتینگ را در حالتی که \vec{p} در امتداد محور Z ها باشد، بدست آورید. (\vec{p} گشتاور الکتریکی توزیع بار است.)